

• **Атомная структура и неэлектронные свойства полупроводников**

Авачева Т.Г., Бодягин Н.В., Вихров С.П., Мурсалов С.М.
Исследование самоорганизации неупорядоченных материалов с применением теории информации 513

Беляев А.П., Рубец В.П., Антипов В.В., Тошходжаев Х.А.
Сравнительный анализ механизмов формирования межфазной границы пленочной структуры в равновесных и резко неравновесных условиях 519

• **Электронные и оптические свойства полупроводников**

Булатецкая Л.В., Божко В.В., Давидюк Г.Е., Парасюк О.В.
Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллических соединений $\text{AgCd}_2\text{GaS}_4$ 522

Косяченко Л.А., Герман И.И., Раренко И.М., Захарук З.И., Никонюк Е.С.
Примесная проводимость монокристаллов $\text{Hg}_3\text{In}_2\text{Te}_6$ 528

Кязым-заде А.Г., Салманов В.М., Мохтари А.Г., Дадашова В.В., Агаева А.А.
Электролюминесценция и фототриггерный эффект в монокристаллах твердых растворов $\text{GaS}_x\text{Se}_{1-x}$ 532

Ушаков В.В., Клевков Ю.В.
У- и Z-люминесценция поликристаллического теллурида кадмия, полученного неравновесной реакцией прямого синтеза компонентов 536

Макаренко Ф.В., Прибылов Н.Н., Рембеза С.И., Мельник В.А.
Особенности спектров собственной фотопроводимости в фосфиде индия, компенсированном медью 542

• **Полупроводниковые структуры, границы раздела и поверхность**

Божков В.Г., Торхов Н.А., Ивонин И.В., Новиков В.А.
Исследование свойств поверхности арсенида галлия методом сканирующей атомно-силовой микроскопии 546

Зайцев С.В., Максимов А.А., Тартаковский И.И., Яковлев Д.Р., Вагг А.
Резонансное туннелирование носителей в фотовозбужденных гетероструктурах 2-го типа ZnSe/VTe 555

Лисовский И.П., Злобин С.А., Каганович Э.Б., Манойлов Э.Г., Бегун Е.В.

Инфракрасные спектры пропускания фотолюминесцентных пленок оксидов с Si-, Ge-квантовыми точками, сформированных импульсным лазерным осаждением 560

Данилов Л.В., Зегря Г.Г.

Теоретическое исследование процессов оже-рекомбинации в глубоких квантовых ямах 566

Данилов Л.В., Зегря Г.Г.

Пороговые характеристики ИК-лазера на основе глубоких квантовых ям $\text{InAsSb}/\text{AlSb}$ 573

Юрасов Д.В., Дроздов Ю.Н.

Критическая толщина перехода по Странскому-Крастанову с учетом эффекта сегрегации 579

Елесин В.Ф., Катеев И.Ю.

Высокочастотные свойства двухъямных наноструктур 586

Лисовский И.П., Индутный И.З., Муравская М.В., Войтович В.В., Гуле Е.Г., Шепелявый П.Е.

Усиление фотолюминесценции структур с нанокристаллическим кремнием, стимулированное низкодозовым γ -облучением 591

Разжувалов А.Н., Гриняев С.Н.

Гистерезис туннельного тока в двухбарьерных структурах $w\text{-GaN}/\text{AlGaIn}(0001)$ 595

Белевский П.А., Винославский М.Н., Порошин В.Н., Строганова И.В.

О природе затухающих колебаний тока при образовании статического акустоэлектрического домена в гетероструктурах $n\text{-InGaAs}/\text{GaAs}$ с квантовыми ямами 604

• **Аморфные, стеклообразные, пористые, органические, микрокристаллические полупроводники, полупроводниковые композиты**

Гаджиев Э.Ш., Мадададзе А.И.

Электронографическое исследование параметров ближнего порядка в аморфных пленках $\text{Yb}_{1-x}\text{Sm}_x\text{As}_2\text{S}_4$ 608

Галашев А.Е.

Термическая неустойчивость фуллеренов кремния, стабилизируемых водородом. Компьютерный эксперимент 611

Лебедев Э.А., Гойхман М.Я., Жигунов Д.М., Подешво И.В., Никитин С.Е., Форш П.А., Кудрявцев В.В., Якиманский А.В.

Собственная люминесценция Tb в металл-полимерных комплексах подиаминокислот 618

● **Физика полупроводниковых приборов**

Бекин Н.А., Шастин В.Н.

Каскадный лазер на мелких донорах в δ -легированных
сверхрешетках GaAs/AlGaAs 622

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов
и структур**

**Жмерик В.Н., Мизеров А.М., Шубина Т.В., Плотни-
ков Д.С., Загорянская М.В., Яговкина М.А., Домра-
чева Я.В., Ситникова А.А., Иванов С.В.**

Особенности пространственного распределения In в эпи-
таксиальных слоях InGaN, выращенных молекулярно-
пучковой эпитаксией с плазменной активацией 630